

深圳市晶导电子有限公司

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.



POWER MOSFET

650V N-Channel VDMOS 使用及贮存时需防静电 符合 RoHS 等环保指令要求

1. 主要用途

主要用于充电器、LED驱动、PC 辅助电源等各类功率开关电路

2. 主要特点

- I 开关速度快
- I 通态电阻小,输入电容小

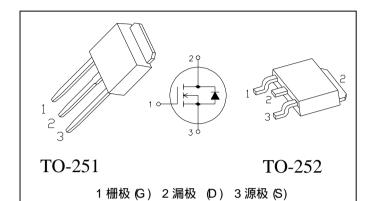
3. 封装外形

TO-251/TO-252

4. 电特性

4.1极限值

除非另有规定, Tamb= 25



参 数 名 称	符号	额定值	单位
漏极-源极电压	$V_{ m DSS}$	650	V
连续漏极电流	I_{D}	2.0	A
漏极脉冲电流	I_{DM}	8.0	A
栅极-源极电压	V_{GS}	± 30	V
单脉冲雪崩能量	E _{AS}	80	mJ
热阻 (结到壳)	R _{JC}	4.46	/W
耗散功率(Ta=25)	P_{tot}	28	W
结温	T_{j}	150	
贮存温度	$T_{\rm stg}$	-55 ~ 150	

4.2 电参数

除非另有规定, Tamb= 25

MAF) HALL , 1 _{amb} — 23			1			I
参数名称	符号) 测试条件	规 范 值			单位
		炒以 开厂	最小	典型	最大	丰世
漏源击穿电压	BV_{DSS}	V_{GS} =0V , I_D =250 μ A	650			V
通态电阻	${ m R_{DSON}}^*$	$V_{GS}=10V$, $I_D=1A$		3.6	4.3	
阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}$, $I_{D}=250 \mu A$	2		4	V
漏源漏电流	I_{DSS}	V _{DS} =650V , V _{GS} =0V			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
源漏二极管正向压降	${ m V_{SD}}^*$	$I_S=2A$, $V_{GS}=0V$			1.5	V
关断延迟时间	$t_{d(off)}$	V_{DD} =300V , I_{D} =2A	22			
		$R_G=18$, $V_{GS}=10V$		33		ns
输入电容	C _{iss}	W ON W 25W		280		pF
输出电容	C_{oss}	$V_{GS}=0V$, $V_{DS}=25V$		30		pF
反向传输电容	C_{rss}	f=1.0MHZ		4.5		pF

* 脉冲测试:t_P 300us, 2%

* L=10mH , $I_D=2A$, $T_J=25$

地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515



深圳市晶导电子有限公司

ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.



5特性曲线

图 1 安全工作区(直流)

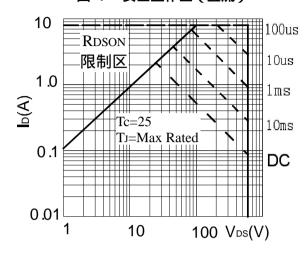


图 2 Ptot-T关系曲线

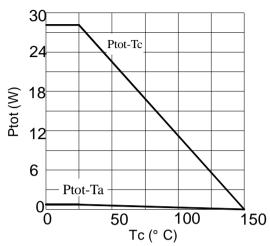


图 3 传输特性曲线

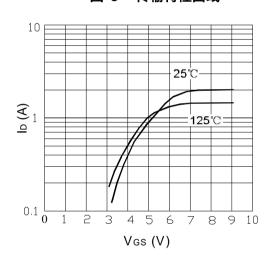


图 4 通态电阻-温度关系曲线

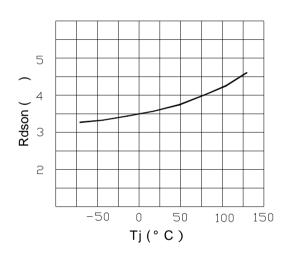


图 5 击穿电压 温度关系曲线

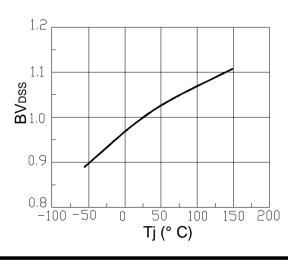
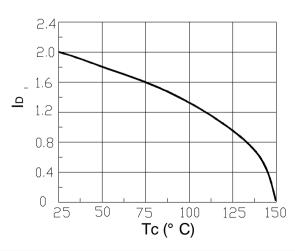


图 6 漏极电流 温度关系曲线



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园3号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515



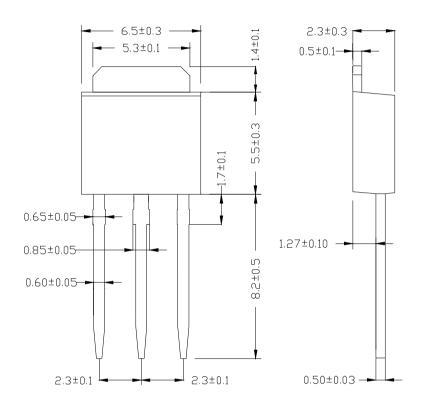
深圳市晶导电子有限公司

OV2N65C
POWER MOSFET

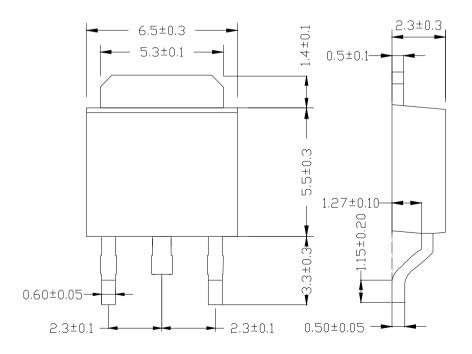
ShenZhen Jingdao Electronic Co.,Ltd.

6. 产品外形尺寸图 (单位: mm)

TO-251



TO-252



地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 3 号厂房 电话:0755-29799516 传真:0755-29799515